

## Curso Geral de PI

**Vanessa Fatal**  
Examinadora patentes



# PPP

## PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE

Universidade de Évora | 12.10.2010

- I. Definição de PPP**
- II. Necessidades a que o PPP responde**
- III. Vantagens dos PPPs**
- IV. Requisitos dos PPPs**
- V. Conversão em pedido definitivo**
- VI. Custos associados**
- VII. Alteração ou adição de matéria técnica**
- VIII. Utilização do PPP para a extensão do pedido**
- IX. Alguns dados estatísticos dos PPPs**
- X. Exemplo de PPP**
- XI. Exemplo de conversão do PPP**

**QUEM?** Qualquer pessoa independentemente da nacionalidade e do local de residência.

**ONDE?** On-line / Pessoalmente / Via CTT / Fax

## COMO?

### O PEDIDO

DESCRIÇÃO  
REIVINDICAÇÕES  
DESENHOS  
RESUMO

Falta de tempo



Falta de financiamento

Pressão para divulgar



### PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE (PPP)

DOCUMENTO QUE  
DESCREVA A INVENÇÃO

Podem ser entregues em português ou inglês.

## O QUE É

- Forma simples, fácil e acessível para apresentar um pedido de patente
- Sendo apenas necessário:

- Apresentar a identificação do requerente
- Entregar (PT ou IN) documento que descreva a invenção  
(**por ex.:** um *paper* científico)
- Efectuar pagamento de uma taxa reduzida

**Validade:** Período máximo de 12 meses

Pode em qualquer altura ser convertido em pedido definitivo

## PRINCIPAIS REQUISITOS



- Descrever a invenção de forma a permitir a sua execução por **qualquer pessoa** competente na matéria
- Exibir todas as características técnicas que serão depois reivindicadas no pedido definitivo
- Pode estar em **Português** ou em **Inglês**

## O PPP PERMITE

- **Divulgação da invenção** em simultâneo com o pedido de patente
- **Fixar a prioridade** de forma imediata e sem grandes exigências formais
- **Adiar 12 meses** a formalização de um pedido completo de patente
- Assegurar a **confidencialidade da invenção** → PPP não é publicado
- Averiguar o estado da técnica → Pode ser requerida pesquisa
- **Reduzir investimento inicial** → 1 ano para avaliação da potencialidade
- Decidir sobre a real possibilidade de aplicação industrial ou aperfeiçoar a própria invenção (*desde que a matéria esteja contemplada no pedido provisório*)

## TER EM ATENÇÃO

- O PPP **não permite reivindicar a prioridade** de um pedido anterior
- **Pode não ser** admissível em alguns países como forma de marcar a prioridade → Requerente deve sempre informar-se sobre os requisitos impostos nos países onde deseja proteger a sua invenção
- Pedido provisório redigido de forma **demasiado simplificada, vaga ou abrangente** → Não produz efeito útil aquando da conversão
- Pedido provisório **muito restrito** → Limita o âmbito de protecção da patente

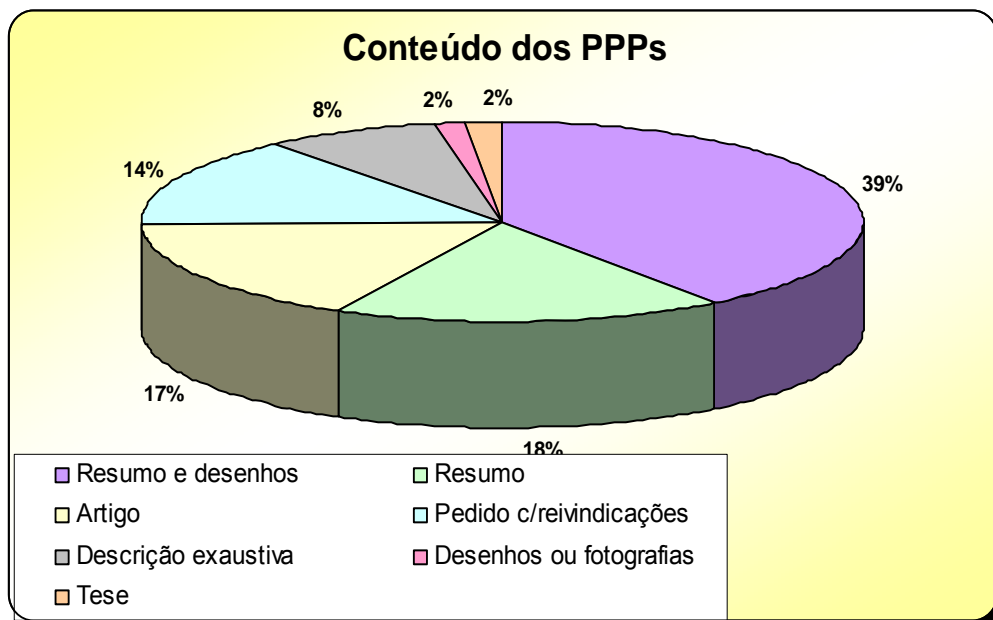


## Conteúdos adequados:

- Artigos Científicos
- Teses
- Descrições (exaustivas)
- Pedidos com reivindicações

## Conteúdos inadequados:

- Resumos
- Resumos e desenhos
- Só fotografias ou desenhos
- Descrições muito gerais (*pouca matéria técnica*)



**Afecta directamente o Potencial  
de Patenteabilidade do PPP**

## O QUE FAZER A SEGUIR



 **Pesquisa ao estado da técnica existente naquele momento**

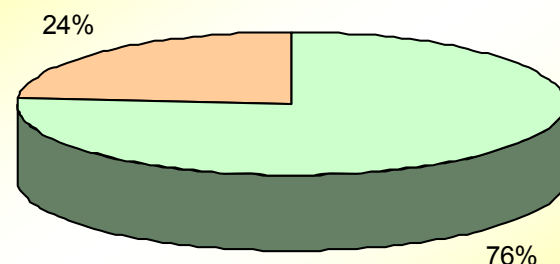
 **Relatório com comentários do examinador**

(se a pesquisa tiver sido solicitada e **CASO EXISTA** matéria pesquisável)

### **Casos em que não existe matéria pesquisável:**

- Limitações quanto ao objecto
- Limitações quanto à patente
- Outros direitos de PI
- Direitos de autor

**Pedido de Relatório de Pesquisa**



■ Relatório de Pesquisa Pedido ■ Relatório de Pesquisa não Pedido

## COMO CONVERTER EM PEDIDO DEFINITIVO

(Antes de *esgotados os 12 meses*, o requerente deve solicitar a *conversão* do PPP num pedido definitivo)

■ Apresentar, em PT {

- Resumo
- Descrição
- Reivindicações
- Desenhos



■ Efectuar o pagamento da taxa correspondente a um pedido definitivo de patente



Se o pedido *não for convertido* dentro do prazo, o requerente perde todos os benefícios e o *pedido é considerado retirado*

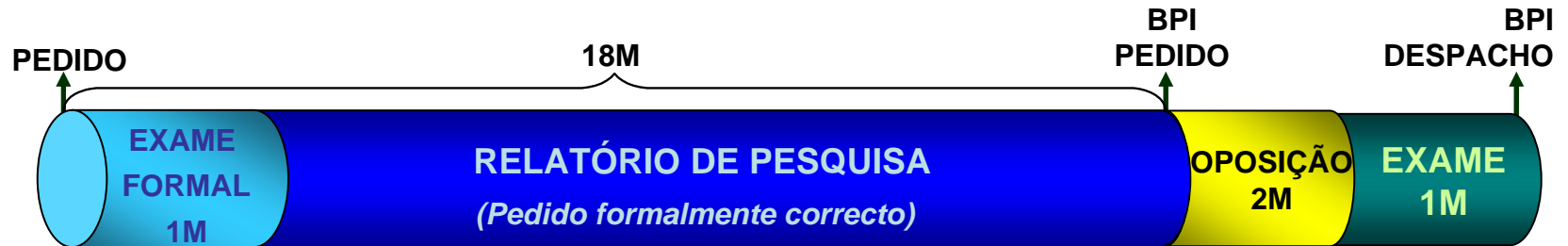
*(assegura a confidencialidade da invenção, o PPP não é publicado)*

## CUSTOS ASSOCIADOS AO PPP/PD

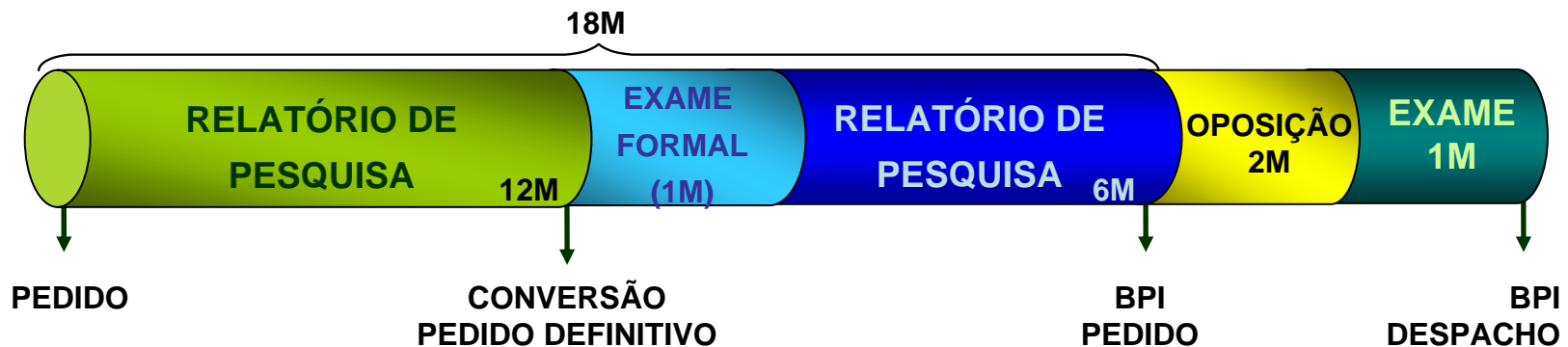
	Euros	
	<i>Online</i>	Papel
<b>Pedido Provisório</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>Pesquisa</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
<b>Conversão em Pedido Definitivo</b>	<b>70</b>	<b>140</b>
<b>Pedido Definitivo</b>	<b>100</b>	<b>200</b>



## PEDIDO DEFINITIVO DE PATENTE (PDP)



## PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE (PPP)



## SITUAÇÃO REGULAR

PEDIDO PROVISÓRIO DE  
PATENTE (PPP)

CONVERSÃO EM  
PEDIDO DEFINITIVO



12 MESES

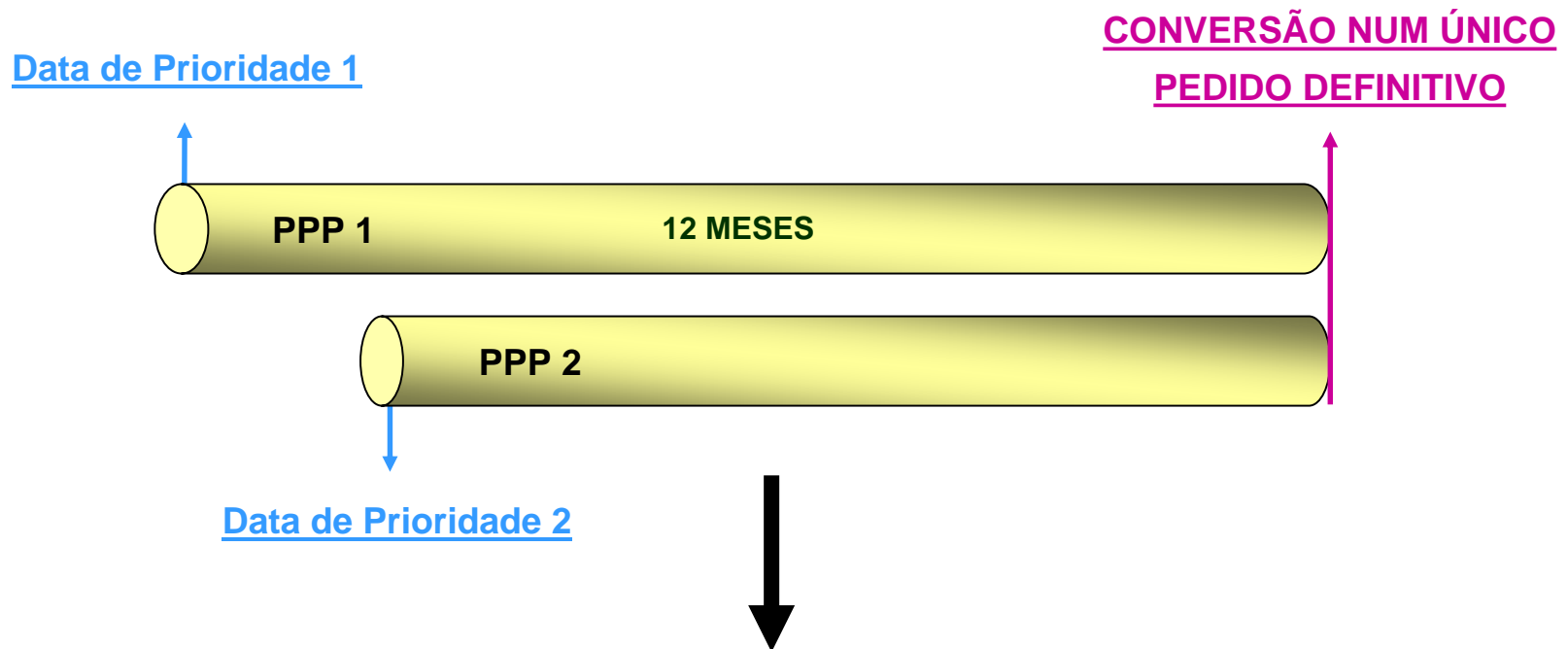
=

*(Data de Prioridade)*



***Pedido definitivo com a data de prioridade do PPP***

## SITUAÇÃO NÃO REGULAR

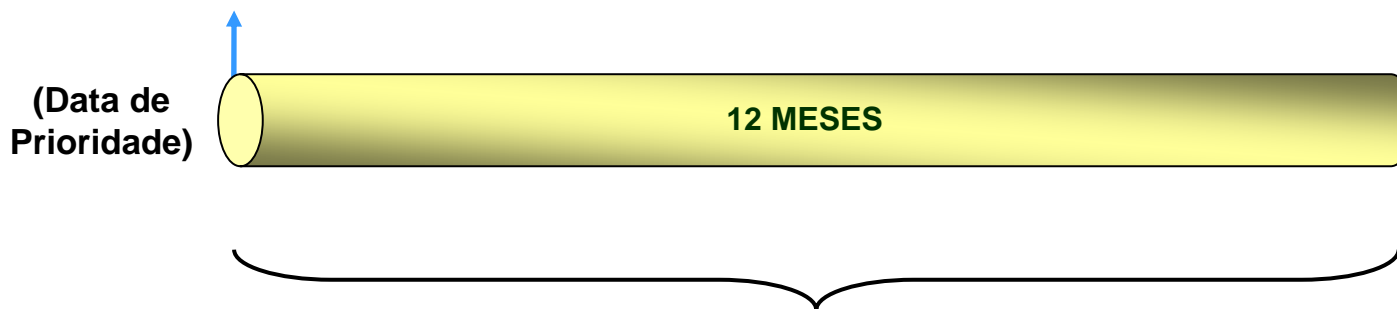


**Pedido definitivo com as datas de prioridade dos dois PPPs:**

Matéria A (PPP 1): data de prioridade 1 + Matéria B (PPP 2): data de prioridade 2

## PEDIDOS NOUTROS PAÍSES

APRESENTAÇÃO (PPP)



CONVERSÃO EM PEDIDO DEFINITIVO

E

EXTENSÃO DO PEDIDO A OUTROS PAISES

- EP
- PCT
- JP, CN, KR...

## PEDIDO DEFINITIVO

### REIVINDICAÇÃO

1. Utilização de vírus contendo o gene terapêutico X **caracterizado por** ser aplicado no transporte do referido gene para dentro células hepáticas ou pulmonares

## PPP

### ARTIGO SOBRE TERAPIA GENÉTICA

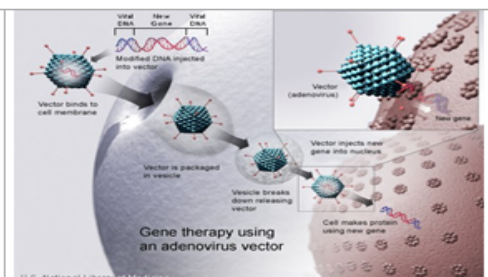
#### INTRODUÇÃO

A **Terapia genética** é a inserção de **genes** nas **células** e **tecidos** de um indivíduo para o tratamento de uma doença; em especial, **doenças hereditárias**. A terapia genética visa a introdução de **alelos** funcionais daqueles que são defeituosos. Embora a tecnologia ainda esteja num estágio inicial, tem sido usada com algum sucesso.

#### PROCESSO BÁSICO

Na maioria dos estudos a respeito de terapia genética, um gene "normal" é inserido no **genoma** para substituir um gene "anômalo" causador de doença. Uma molécula transportadora, chamada **vector**, é usada para enviar o gene terapêutico para as **células-alvo** do paciente.

Actualmente, o vector mais comum é um vírus que foi geneticamente alterado para transportar **DNA** humano normal.



Os vírus evoluíram de forma a encapsular e transportar os seus genes para células humanas, causando assim doenças. Cientistas tentaram aproveitar essa capacidade para manipular o **genoma** dos vírus, removendo os genes causadores de doenças e inserindo genes terapêuticos.

**Células-alvo**, tais como as células do fígado ou dos pulmões do paciente, são infectadas com o vector. O vector, então, descarrega o seu material genético, contendo o gene terapêutico humano, na **célula-alvo**. A produção de proteínas funcionais pelos genes terapêuticos restaura as **células-alvo**, conferindo-lhes um estado de normalidade.

#### TIPOS DE TERAPIA GENÉTICA

Teoricamente é possível transformar tanto **células somáticas** (a maior parte das células do corpo) como **células germinativas** (**espermatozoides**, **óvulos**, e as suas **células-tronco** precursoras). Todas as terapias genéticas realizadas até agora em humanos foram dirigidas a células somáticas, enquanto a engenharia de células germinativas continua altamente controversa. Para que os genes introduzidos sejam transmitidos normalmente para a descendência, é necessário que estes sejam inseridos na célula e incorporados nos **chromossomos** por **recombinação genética**.

A terapia genética com genes somáticos pode ser dividida em duas grandes categorias: *ex vivo* (em que as células são modificadas fora do corpo e, então, transplantadas novamente para o paciente) e *in vivo* (em que os genes são modificados nas células ainda dentro do corpo). Abordagens *in vivo* baseadas em recombinação são especialmente iniciais.

## ARTIGO

### Título

**Characterization of Planar Semipolar Gallium Nitride Films on Sapphire Substrates**

Troy J. Baker<sup>1,3</sup>, Benjamin A. Haskell<sup>1,3</sup>, Feng Wu<sup>1,3</sup>, James S. Speck<sup>1,3</sup> and Shuji Nakamura<sup>1,2,3</sup>

### Autores

<sup>1</sup>Materials Departments, University of California, Santa Barbara, CA 93106, U.S.A.

<sup>2</sup>Electrical Engineering Departments, University of California, Santa Barbara, CA 93106, U.S.A.

<sup>3</sup>NICP/ERATO JST, UCSB Group, University of California, Santa Barbara, CA 93106, U.S.A.

(Received October 27, 2005; accepted December 26, 2005; published online February 3, 2006)

### Abstract:

### Resumo

Specular, planar semipolar gallium nitride films were grown by hydride vapor phase epitaxy. Planar (10 $\bar{1}$ 3) and (11 $\bar{2}$ 2) GaN have been grown on (10 $\bar{1}$ 0) *m*-plane sapphire. The in-plane epitaxial relation (10 $\bar{1}$ 3) GaN was [30 $\bar{3}$ 2]<sub>GaN</sub> || [1 $\bar{2}$ 10]<sub>sapphire</sub> and [1 $\bar{2}$ 10]<sub>GaN</sub> || [0001]<sub>sapphire</sub>. The in-plane epitaxial relation (11 $\bar{2}$ 2) GaN was [11 $\bar{2}$ 1]<sub>GaN</sub> || [0001]<sub>sapphire</sub> and [1100]<sub>GaN</sub> || [1 $\bar{2}$ 10]<sub>sapphire</sub>. The (10 $\bar{1}$ 3) films were determined to have N-face sense polarity and a threading dislocation density of 9×10<sup>8</sup> cm<sup>-2</sup>. The (11 $\bar{2}$ 2) films have M-face sense polarity and have a threading dislocation density of 2×10<sup>10</sup> cm<sup>-2</sup>. The basal plane stacking fault was 2 ×10<sup>5</sup> cm<sup>-1</sup> for both orientations. The RMS roughness of the films was under 10 nm for a 5 ×5 μm area. ©2006 The Japan Society of Applied Physics

## PPP

### Ligeira alteração no título sem alteração do conteúdo

Provisional Patent Application

for:

**TECHNIQUE FOR THE GROWTH OF PLANAR SEMI-POLAR GALLIUM NITRIDE**

### Autores principais com designação de inventores

Inventors:

Troy J. Baker, Benjamin A. Haskell, Paul T. Fini,  
Steven P. DenBaars, James S. Speck and Shuji Nakamura

### Mandatário

Prepared By:

Gates & Cooper LLP

Howard Hughes Center

6701 Center Drive West, Suite 1050

Los Angeles, California 90045

### Reformulação do texto mas sem alteração do conteúdo

**TECHNIQUE FOR THE GROWTH OF PLANAR SEMI-POLAR GALLIUM NITRIDE**

#### ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

A method for growing planar films of semi-polar nitrides on a miscut spinel substrate, in which a large area of the semi-polar nitrides is parallel to the substrate's surface. The planar films and substrates are: (1) {10 $\bar{1}$ 1} gallium nitride (GaN) grown on a {100} spinel substrate miscut in specific directions, (2) {10 $\bar{1}$ 3} gallium nitride (GaN) grown on a {110} spinel substrate, (3) {11 $\bar{2}$ 2} gallium nitride (GaN) grown on a {1 $\bar{1}$ 00} sapphire substrate, and (4) {10 $\bar{1}$ 3} gallium nitride (GaN) grown on a {1 $\bar{1}$ 00} sapphire substrate



PCT



(43) International Publication Date  
21 September 2006 (21.09.2006)

(10) International Publication Number  
**WO 2006/099138 A2**

(51) International Patent Classification:  
**H01L 29/15** (2006.01) **H01L 31/0312** (2006.01)

(21) International Application Number:  
PCT/US2006/008595

(22) International Filing Date: 10 March 2006 (10.03.2006)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:  
60/660,283 10 March 2005 (10.03.2005) US

(71) Applicant (for all designated States except US): **THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA** [US/US]; 1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607 (US).

(72) Inventors; and  
(75) Inventors/Applicants (for US only): **BAKER, Troy, J.**

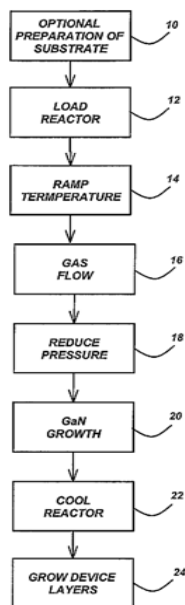
[US/US]; 4986 Calle Real, Santa Barbara, California 93111 (US). **HASKELL, Benjamin, A.** [US/US]; 724 Kroeber Walk, #207, Goleta, California 93117 (US). **FINI, Paul, T.** [US/US]; 218 West Mason Street, Santa Barbara, California 93101 (US). **DENBAARS, Steven, P.** [US/US]; 287 King Daniel Lane, Goleta, California 93117 (US). **SPECK, James, S.** [US/US]; 947 West Campus Lane, Goleta, California 93117 (US). **NAKAMURA, Shuji** [US/US]; P.O. Box 61656, Santa Barbara, California 93160 (US).

(74) Agent: **GATES, George, H.**; Gates & Cooper LLP, 6701 Center Drive West, Suite 1050, Los Angeles, California 90045 (US).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[Continued on next page]

(54) Title: **TECHNIQUE FOR THE GROWTH OF PLANAR SEMI-POLAR GALLIUM NITRIDE**



(57) Abstract: A method for growing planar, semi-polar nitride film on a miscut spinel substrate, in which a large area of the planar, semi-polar nitride film is parallel to the substrate's surface. The planar films and substrates are: (1) {101 1} gallium nitride (GaN) grown on a {100} spinel substrate miscut in specific directions, (2) {1013} gallium nitride (GaN) grown on a {110} spinel substrate, (3) {1122} gallium nitride (GaN) grown on a {1100} sapphire substrate, and (4) {1013} gallium nitride (GaN) grown on a {1100} sapphire substrate.

Inventores

Representante legal

Título

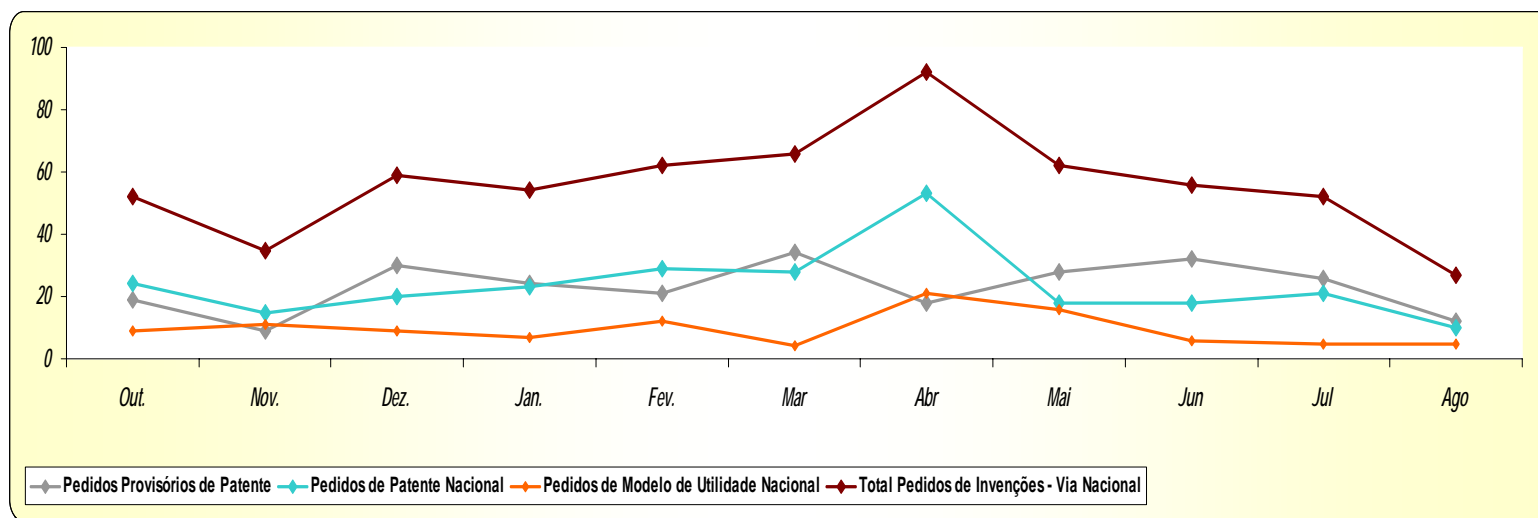
Resumo

**PEDIDO DEFINITIVO**

WO 2006/099138 A2

Pedidos de Invenções (Via Nacional)	2008			2009							
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
PPPs	19	9	30	24	21	34	18	28	32	26	12
Pedidos de Patente	24	15	20	23	29	28	53	18	18	21	10
Pedidos de Modelo de Utilidade	9	11	9	7	12	4	21	16	6	5	5
<b>Total Pedidos de Invenções</b>	52	35	59	54	62	66	92	62	56	52	27
<b>% PPPs vs Total Pedidos</b>	37	26	51	44	34	52	20	45	57	50	44

*Evolução dos PPPs em relação a outros pedidos para o período de Outubro de 2008 a Agosto de 2009*



# OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!



## OS NOSSOS CONTACTOS

**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL**

**Campo das Cebolas 1149-035 Lisboa**

**Linha de informações: 808 200 689 / Site: [www.inpi.pt](http://www.inpi.pt)**

**Tel: (+351) 218 818 100 / Fax: (+351) 218 869 859**